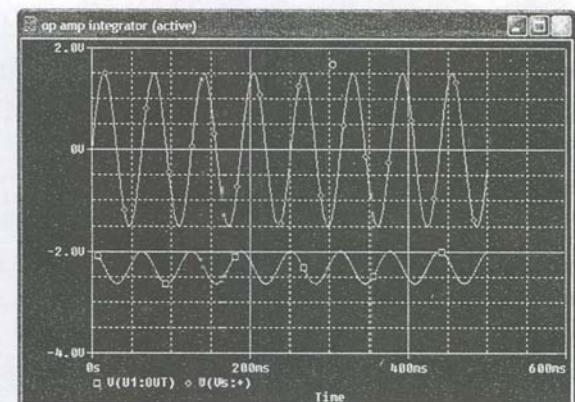


شکل ۷-۴۲ خروجی probe مدار انتگرال شبیه‌سازی شده همراه با ورودی برای مقایسه.



مشخص می‌سازد. PSpice خود اقدام به انتخاب فواصل زمانی منفصل، برای محاسبه ولتاژها و جریان‌های مختلف می‌نماید. گاهی پیام خطای مبنی بر عدم وجود حل گذرا دریافت می‌شود. در این گونه موارد، بهتر است مقادیر برای Step Celling را در تیم که حداقل گام زمانی بین محاسبات است. البته هرچه گام کوچک‌تر باشد بهتر است. با توجه به تحلیل قبلي و معادله (۱۷)، انتظار داریم که خروجی برابر با منفی انتگرال موج ورودی یعنی $V_{out} = 0.319 \cos(100t) - 2.319$ می‌باشد. مقادیر اولیه ۲ ولت در دو سر خازن با مقدار ثابتی ترکیب می‌شود که حاصل انتگرالگیری است و نتیجه‌اش مقدار متوسط غیرصفیری در خروجی است.

۷-۸ خلاصه فصل و مرور

- جریان درون یک خازن $i = C \frac{dv}{dt}$ است.
- ولتاژ دو سر خازن با رابطه زیر به جریانش مرتبط است:
$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(t') dt' + v(t_0)$$
- یک خازن برای جریان‌های dc به صورت مدار باز عمل می‌کند.
- ولتاژ دو سر یک القاگر با رابطه $v = L \frac{di}{dt}$ معین می‌گردد.
- جریان عبوری از القاگر با رابطه زیر به ولتاژ مربوط می‌شود:

$$i(t) = \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v dt' + i(t_0)$$

- یک القاگر در جریان‌های dc به صورت مدار اتصال کوتاه عمن می‌نماید.
- انرژی ذخیره‌شده فعلی در یک خازن برابر $\frac{1}{2} CV^2$ است، در حالی که انرژی ذخیره‌شده در یک القاگر $\frac{1}{2} Li^2$ می‌باشد. مرتع هر دوی آن‌ها به زمانی است که در آن‌ها انرژی بیوده است.
- ترکیبات سری و موازی القاگرها را می‌توان با روابطی مشابه مقاومت‌ها در هم ادغام کرد.
- ترکیبات سری و موازی خازن‌ها را می‌توان بر عکس مقاومت‌ها تصور کرد.
- خازنی که در یک op amp مکوس‌گر به عنوان عنصر پسخورد به کارمی‌رود ولتاژ خروجی متناسب با انتگرال ولتاژ ورودی را تولید می‌نماید. با توجه مقاومت ورودی با خازن پسخورد، ولتاژ خروجی متناسب با مشتق ورودی خواهد بود.
- جون خازن‌ها و القاگرها عنصر خطی ند، KCL، KVL، تجمعی، قضایای تونن و نورتن و تحلیل‌های گرهی و مش به مدار آن‌ها قابل اعمال است.

۷-۱ خازن

- جریان درون خازن $10\mu F$ را در ازای ولتاژهای دو سر آن حساب کنید.
- مقطع پیوند و عرض ناحیه تهی پیوند است. W نه تنها به ساخت آن لکه به ولتاژ اعمال شده به دو پایانه نیز بستگی دارد:

$$W = \sqrt{\frac{2K_s \epsilon_0}{qN}} (V_{bi} - V_A)$$

بنابراین دیودها غالباً در مدارهای الکترونیک به عنوان خازن‌های کنترل شده با ولتاژ به کار می‌روند. با این فرض که مقادیر پارامترها، $q = 1.6 \times 10^{-19} C$ و $V_{bi} = 0.57V$ ، $N = 10^{18} cm^{-3}$ باشند، فرقیت خازن دیود با سطح مقطع $1\mu m \times 1\mu m = 1\mu m^2$ در ولتاژ $-10V$ ، $V_A = -5V$ و $V_{bi} = -1V$ را بدست آورید.

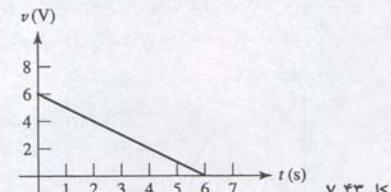
۷. خازنی طراحی کنید که ظرفیتش به صورت دستی با چرخش و لوم بین $10pF$ و $1nF$ تغییر کند. طرح خود را برچسب‌های مناسب توضیح دهید.

۸. ولتاژ زیر به یک خازن $300\mu F$ وصل است:

$$v(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 3e^{-t/5} V & t > 0 \end{cases}$$

(الف) انرژی ذخیره شده در خازن در $t = 2ms$ چقدر است. (ب) در چه مدتی انرژی ذخیره شده در خازن به 37% مقدار جدا کشش افت می‌کند. (ج) جریان عبوری از خازن $t = 1.2s$ را معین نمایید. (د) توان انتقالی به سیله خازن به مدار خاصی در $t = 2s$ را حساب کنید.

۹. جریان درون خازن $47\mu F$ در شکل ۷-۴۴ دیده می‌شود. ولتاژ دو سر آن را در (الف)، $t = 2ms$ ، (ب)، $t = 4ms$ و (ج)، $t = 5ms$ حساب کنید.



۳. جریان جاری درون خازن $1m\Phi$ را در پاسخ به ۷ ولت در دو سر پایانه‌ها را حساب کنید. اگر ۷ ولت باشد، (الف) $4e^{-t/30te^{-30te^{-4.5t}}}$ و (ب) $4e^{-5t} \sin(100t)V$.

۴. حداقل مقدار انرژی که در هر یک از خازن‌های الکترونیک شکل ۷-۲ (ب) و (ج) می‌توان ذخیره کرد، مقدار است؟

۵. خازنی از دو قرص الومینیومی نازک با قطر $1cm$ و فاصله $100\mu m$ از یکدیگر ساخته شده است. (الف) ظرفیت آن را حساب کنید با فرض این که فقط هوا در بین صفحات وجود داشته باشد. (ب) ولتاژی را معین کنید که باید برای ذخیره $1mJ$ انرژی در خازن به کاربرد. (ج) اگر بخواهیم خازن $2.5\mu J$ انرژی را در $100V$ ذخیره کند ضریب گذرهای نسبی E/E_0 برای ناحیه بین صفحات را مشخص کنید.

۶. یک دیود پیوندی $p-n-p$ با ظرفیت پیوندی زیر تعریف شده است:

$$C_j = \frac{K_s \epsilon_0 A}{W}$$

۷-۹ خواندنی‌های کمکی

A detailed guide to characteristics and selection of various capacitor and inductor types can be found in:

H. B. Drexler, *Passive Electronic Component Handbook*, 2nd ed., C. A. Harper, ed. New York: McGraw-Hill, 2003, pp. 69–203.

C. J. Kaiser, *The Inductor Handbook*, 2nd ed. Olath, Kans.: C.J. Publishing, 1996.

Two books that describe capacitor-based op amp circuits are:

R. Mancini, (ed.), *Op Amps Are For Everyone*, 2nd ed. Amsterdam: Newnes, 2003.

W. G. Jung, *Op Amp Cookbook*, 3rd ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1997.

که برای سیلیکان $K_s = 11.8$ است، ضریب گذرهای خلا، A برای سطح مقطع پیوند و W عرض ناحیه تهی پیوند است. W نه تنها به ساخت آن لکه به ولتاژ اعمال شده به دو پایانه نیز بستگی دارد:

بنابراین دیودها غالباً در مدارهای الکترونیک به عنوان خازن‌های کنترل شده با ولتاژ به کار می‌روند. با این فرض که مقادیر پارامترها، $q = 1.6 \times 10^{-19} C$ و $V_{bi} = 0.57V$ ، $N = 10^{18} cm^{-3}$ باشند، فرقیت خازن دیود با سطح مقطع $1\mu m \times 1\mu m = 1\mu m^2$ در ولتاژ $-10V$ ، $V_A = -5V$ و $V_{bi} = -1V$ را بدست آورید.

۷. خازنی طراحی کنید که ظرفیتش به صورت دستی با چرخش و لوم بین $10pF$ و $1nF$ تغییر کند. طرح خود را برچسب‌های مناسب توضیح دهید.

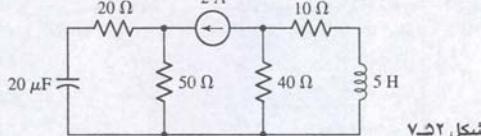
۸. ولتاژ زیر به یک خازن $300\mu F$ وصل است:

$$v(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 3e^{-t/5} V & t > 0 \end{cases}$$

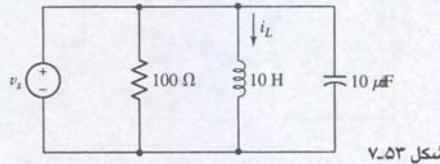
(الف) انرژی ذخیره شده در خازن در $t = 2ms$ چقدر است. (ب) در چه مدتی انرژی ذخیره شده در خازن به 37% مقدار جدا کشش افت می‌کند. (ج) جریان عبوری از خازن $t = 1.2s$ را معین نمایید. (د) توان انتقالی به سیله خازن به مدار خاصی در $t = 2s$ را حساب کنید.

۹. جریان درون خازن $47\mu F$ در شکل ۷-۴۴ دیده می‌شود. ولتاژ دو سر آن را در (الف)، $t = 2ms$ ، (ب)، $t = 4ms$ و (ج)، $t = 5ms$ حساب کنید.

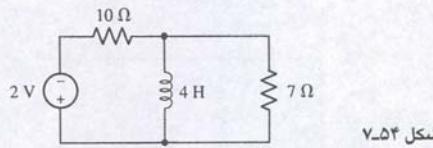
۲۷. با مراجعه به شکل ۷.۵۲ (الف) v_L , v_C , (ب) i_L , (ج) ولتاژ دو سر هر عنصر مدار و جریان در هر عنصر را باید مدار و (د) جریان در هر عنصر را باید.



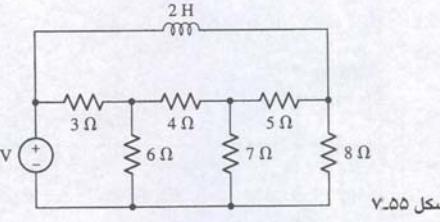
۲۸. اجازه بهدید $i_L(0) = 0.5A$ و $v_s = 400t^2 V$, $t > 0$ را در مدار داشته باشیم. در $0.4s$, $t = 0.4s$, مقادیر انرژی (الف) ذخیره شده در خازن، (ب) ذخیره شده در القاگر و (ج) تلفشده در مقاومت را از $t = 0.4s$ حساب کنید.



۲۹. برای مدار شکل ۷.۵۴، (الف) توان تلفشده با مقاومت‌های 7Ω و 10Ω را محاسبه کنید. صحت جواب را با PSpice تحقق نمایید.

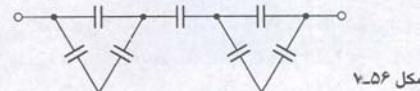


۳۰. (الف) معادل تونن شبکه متصل القاگر شکل ۷.۵۵ را به دست آورید. (ب) جریان داخل القاگر را به دست آورید. (ج) صحت جواب خود را با PSpice تحقیق نمایید. به نتایج خود نام مناسبی بدهد.

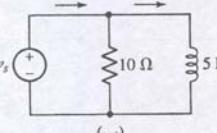
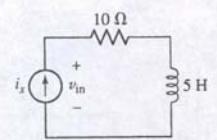


۷-۳ ترکیب القاگرها و خازن‌ها

۳۱. ظرفیت معادل شبکه شکل ۷.۵۶ را اگر همه خازن‌ها $10\mu F$ باشند، معین کنید.



شکل ۷.۵۶



شکل ۷-۴۹

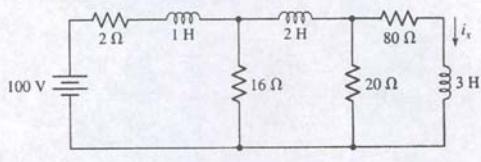
۲۹. ولتاژ v_L در دو سر القاگر $0.2H$ در $t \leq 10ms$ برابر $100V$ است.

در فاصله زمانی $0 < t < 20ms$ به طور خطی به صفر می‌رسد. در $20 < t < 30ms$ آن صفر است. با فرض قرارداد علامت عنصر غیرفعال برای v_L و i_L (الف) i_L را در $t = 8ms$ به دست آورید، به شرطی که $i_L(0) = -2A$ (ب) انرژی ذخیره شده در $t = 22ms$ را معین کنید، به شرطی که $i_L(0) = 0$ فرض شود.

۳۰. مدار شکل ۷.۵۷ از مدت‌ها قبل وصل شده است، از آن پیدا کنید.

۳۱. ولتاژ v_L در دو سر القاگر $0.2H$ در $t \leq 10ms$ برابر $100V$ است. اگر در فاصله زمانی $0 < t < 20ms$ به طور خطی به صفر می‌رسد، در $20 < t < 30ms$ آن صفر است. با فرض قرارداد علامت عنصر غیرفعال برای v_L و i_L (الف) i_L را در $t = 8ms$ به دست آورید، به شرطی که $i_L(0) = -2A$ (ب) انرژی ذخیره شده در $t = 22ms$ را معین کنید، به شرطی که $i_L(0) = 0$ فرض شود.

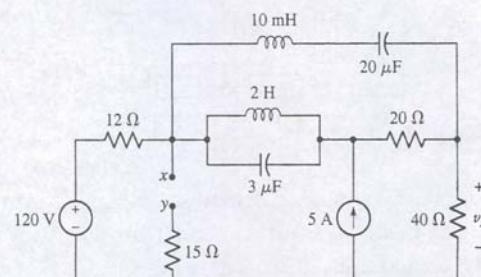
۳۲. مدار شکل ۷.۵۷ از مدت‌ها قبل وصل شده است، از آن پیدا کنید.



شکل ۷-۵۷

۳۳. ولتاژ دو سر يك القاگر $5H$ برابر $v_L(0) = 10(e^{-t} - e^{-2t})$ است. اگر $i_L(0) = 80mA$ باشد و v_L و i_L طبق قرارداد عناصر غیرفعال تعريف شده باشند (الف) $v_L(1s)$, (ب) $i_L(1s)$ و (ج) $i_L(\infty)$ را به دست آورید.

۳۴. پس از مدت زمان طولانی از وصل مدار شکل ۷.۵۱، v_x را باید، به شرطی که (الف) خازن بین x و y باشد و (ب) يك القاگر بین x و y باشد.

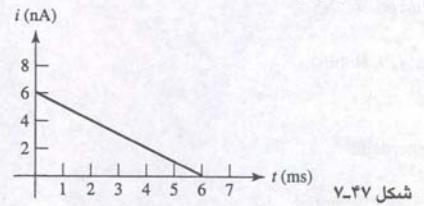


شکل ۷-۵۱

۷-۲ القاگر

۱۵. ولتاژ دو سر يك القاگر را حساب کنید. اگر جریان وارد به پایانه مرجع "+" باشد، (الف) $v_C(t) = 5 \sin \pi t mA$ (ب) $v_C(t) = 115 \sqrt{2} \cos 120 \pi t A$ (ج) $v_C(t) = 4e^{-6t} mA$.

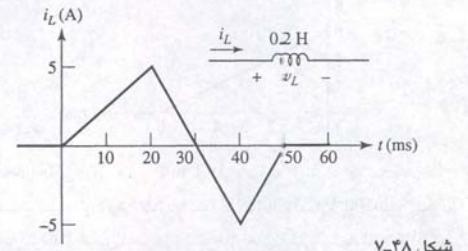
۱۶. ولتاژ ظاهر شده در دو سر القاگر pH را در پاسخ به جریان شکل ۷.۴۷ رسم کنید. فرض کنید که تعريف جریان و ولتاژ با قرارداد قطعات غیرفعال هموخوانی دارد.



۱۷. ولتاژ راکه در دو سر القاگر $5\mu H$ در $t > 0$ را با خصیصه جریان پایانه مرجع "+" ایجاد می‌شود را محاسبه نمایید، اگر آبرابر باشد: (الف) $30te^{-t} nA$ و (ب) $4e^{-et} \sin 100t mA$.

۱۸. حداکثر انرژی ذخیره شده در يك القاگر $5 mH$ چقدر است اگر سیم برای حداقل جریان $1.5 A$ در نظر گرفته شده باشد؟ جواب خود را تشریح کنید.

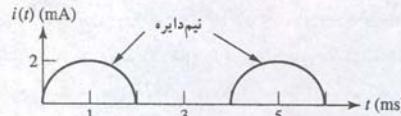
۱۹. با مراجعه به شکل ۷.۴۸: (الف) v_L را به عنوان تابعی از زمان بین $0 < t < 60ms$ رسم کنید. (ب) زمان تولید توان حداکثر را به دست آورید و (ج) انرژی ذخیره شده در القاگر در $t = 40ms$ چقدر است.



۲۰. در شکل ۷.۱۳، فرض کنید $L = 50 mH$ باشد. با فرض $i_L(0) = 0$ در $0 < t < 80ms$ ، حداکثر مقدار $|i_L|$ و $|v_L|$ را زمانی که این حداکثر مقدار دهدند را تعیین نمایید.

۲۱. (الف) اگر در مدار شکل ۷.۴۹ (الف) در $t > 0$ $i_s = 0.4t^2 A$ باشد، در $t > 0$ را برای $v_{in}(t)$ در شکل ۷.۴۹ (ب) رسم کنید.

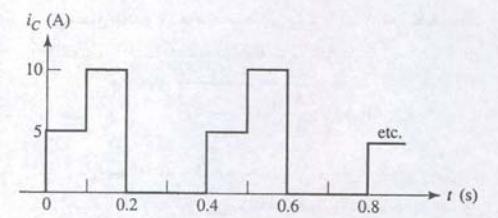
۲۲. ولتاژ v به القاگر $20 mH$ در $t > 0$ را با $v = 20 \cos 1000t V$ اعمال شده است. اگر در $t = 0$ جریان القاگر صفر باشد، در $0 < t < 2\pi ms$ توان جذب شده به وسیله القاگر را رسم کنید. (ب) انرژی ذخیره شده در آن را باید.



شکل ۷-۴۴

۲۳. جریان در يك خازن با رابطه $v_C(t) = 7 \sin \pi t mA$ داده شده است. اگر انرژی ذخیره شده در $200ms$ باشد، مقدار ظرفیت چقدر است؟

۲۴. (الف) اگر خازن شکل ۷-۱ را به ظرفیت $0.2\mu F$ باشد، با (ب) $v_C(t) = 5 + 3 \cos^2 200t V$ حداکثر انرژی ذخیره شده در خازن چیست؟ (ج) اگر در $v_C(t) = 8e^{-100t} mA$ باشد، برای $t > 0$ مقدار i_C را پیدا کنید. (د) اگر برای $t > 0$ $i_C = 8e^{-100t} mA$ باشد، (t) $v_C(0) = 100V$ باشد، (t) $v_C(0) = 250V$ و فرض قرارداد علامت عنصر غیرفعال، در چه فاصله زمانی C بین 2000 و 2100 فقرم می‌گیرد؟

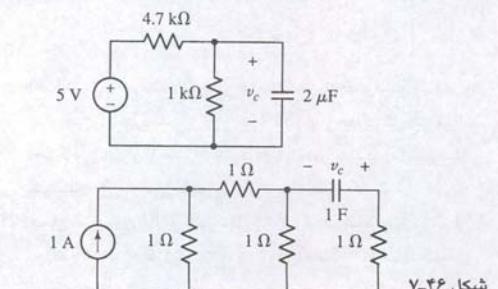


شکل ۷-۴۵

۲۵. مقاومت R با خازن $1\mu F$ موازی است. برای هر $0 \leq t \leq$ انرژی ذخیره شده در خازن برای $0 < t < 1000t mJ$ است. (الف) R را پیدا کنید.

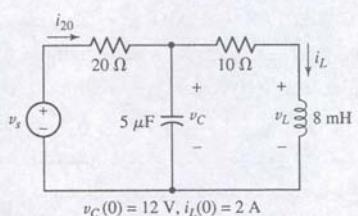
(ب) با تنگرال‌گیری، نشان دهید که انرژی تلفشده در فاصله $0 < t < 0.02 J$ است.

۲۶. برای مدارهای شکل ۷.۴۶، (الف) ولتاژ دو سر هر خازن را محاسبه کنید. (ب) صحت پاسخ خود را با PSpice تحقیق نمایید.



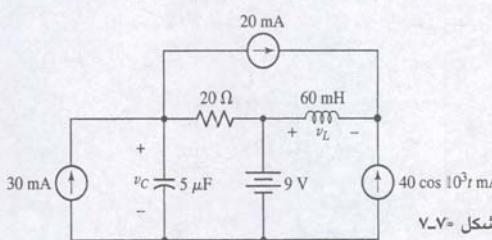
شکل ۷-۴۶

۴۸. (الف) معادلات گرهی را برای شکل ۷.۶۹ بنویسید. (ب) معادلات من را برای آن بنویسید.

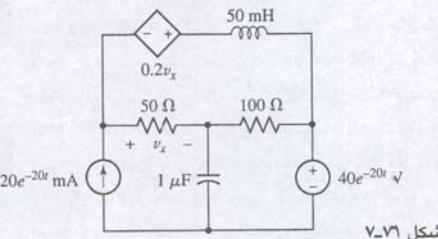


شکل ۷.۶۹

۴۹. اگر فرض شود که همه متغیر در شکل ۷.۷۰ برای مدت میدیدی وصل و کار کوده باشند، از اصل تجمعی برای یافتن $v_{L(t)}$, $v_C(t)$ استفاده کنید.



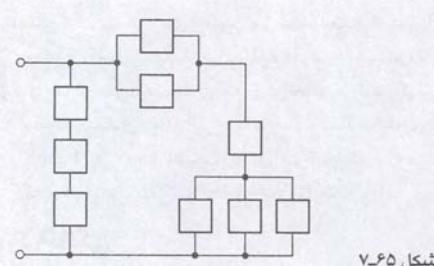
۵۰. برای مدار شکل ۷.۷۱، فرض کنید در $t = 0$ هیچ انرژی ذخیره نشده است. مجموعه معادلات گرهی را بنویسید.



شکل ۷.۷۱

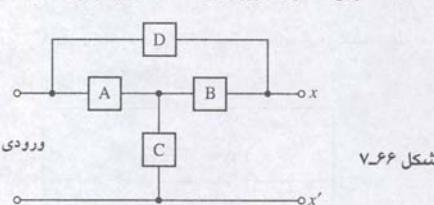
۵۱. جی مقاومت R و C را در مدار شکل ۷.۳۰ تعویض کرده و فرض کنید $A = \infty$ و $R_i = \infty$. (الف) $v_0(t)$ را به صورت تابعی از $i_v(t)$ برسانید. (ب) معادلهای به دست آورید که $v_A(t)$ و $v_0(t)$ را به هم مربوط سازد. به شرطی که A این نهایت نباشد.

۵۲. کشت دهنده یونی دستگاهی است که برای تزریق اتم‌های یونیزه در سیلیکان به کارمی روود، تاشخصهای کالکتریکی ساخت دیده‌ها و ترازیستورها را اصلاح نماید. یون‌هایی که به سیلیکان پرخورد می‌کنند، به جریانی تبدیل می‌شوند و نهایتاً به متغیر معلومی هدایت می‌گردند. جوانان مستقیماً با شدت یون (یعنی تعداد برخورد یون‌ها در ثانیه) مقاومت است. اگر برای تشخیص جوانان از $i = 1.602 \times 10^{-19}$ استناد است، مداری طراحی کنید که



شکل ۷.۶۵

۴۴. در شکل ۷.۶۶، اجزای بدهید تا A, B, C و D (الف) به ترتیب القایرها بباشند، القاینایی ورودی را با $-X'$ باز و سپس اتصال کوتاه پیدا کنید. (ب) به ترتیب خازن‌های ۴F, ۲F, ۱F باز و سپس باشند و آن گاه ظرفیت ورودی را با X' باز و سپس بسته به دست آورید.

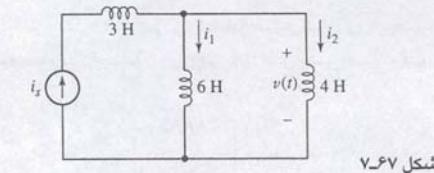


شکل ۷.۶۶

۴۵. با جمعهای بر از خازن‌های 1nF واستفاده از حداقل خازن‌ها، نشان دهید چگونه می‌توان ظرفیت معادل (الف) 2.25nF ، (ب) 0.75nF و (ج) 0.45nF را به دست آورد.

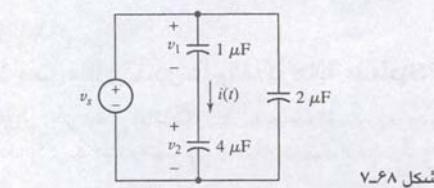
۷-۴ نتایج خطی بودن

۴۶. در مدار شکل ۷.۶۷، اگر $v_x(t)$ را در ازای همه مقادیر $i_v(t)$ بپایاند. (الف) $i_1(t)$ را برای $t \geq 0$ معین کنید.

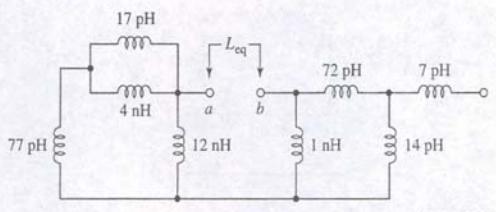


شکل ۷.۶۷

۴۷. اگر در مدار شکل ۷.۶۸، $v_1(0) = 20\text{V}$ و $v_s = 100e^{-80t} \text{V}$ باشد. (الف) $i_1(t)$ را برای همه مقادیر t به دست آورد. (ب) $v_1(t)$ را برای $t \geq 0$ پیدا کنید و (ج) $v_2(t)$ را برای $t \geq 0$ بیانیزد.

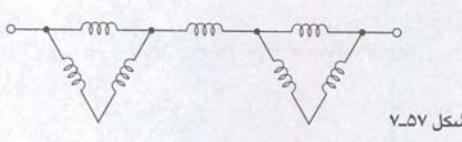


شکل ۷.۶۸



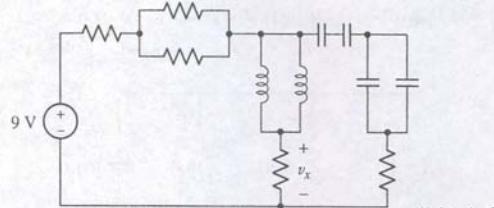
شکل ۷.۶۱

۴۹. القاء معادل شبکه شکل ۷.۵۷ را اگر همه القایرها 77pH باشند، معین نمایید.



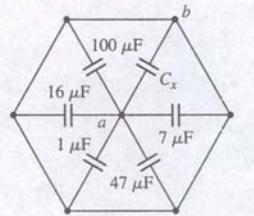
شکل ۷.۵۷

۵۰. برای مدار شکل ۷.۵۸، (الف) مدار را با استفاده از ترکیب سری/موازی تا حداقل اجرا کاهش دهید.



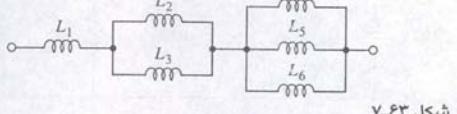
شکل ۷.۵۸

۵۱. شبکه شکل ۷.۶۲ از سه طبقه سری تشکیل شده است که هر کدام تعدادی القایر موازی دارد. (الف) اگر همه القایرها 1.5H باشند، القایر معادل را پیدا کنید. (ب) عبارتی کلی برای شبکه از این نوع با N طبقه به دست آورید.



شکل ۷.۶۲

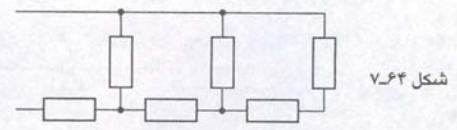
۵۲. شبکه شکل ۷.۶۳ از سه طبقه سری تشکیل شده است که هر کدام تعدادی القایر موازی دارد. (الف) القایرها 1.5H باشند، القایر معادل را پیدا کنید. (ب) عبارتی کلی برای شبکه از این نوع با N طبقه به دست آورید.



شکل ۷.۶۳

۵۳. برای شبکه شکل ۷.۶۴ است. (الف) القایرها 1H باشند، القایرها $L_1 = L_3 = 2\text{H}$ و $L_2 = L_4 = L_5 = L_6 = 3\text{H}$ است. (ب) عبارتی کلی برای شبکه با N طبقه به دست آورید، با این فرض که طبقه N از القایر و هر القایر دارای القاینایی N است.

۵۴. اگر در شکل ۷.۶۴ هر عنصر یک خازن 2pF باشد، با گسترش تبدیل Δ -Y آن را ساده کنید.



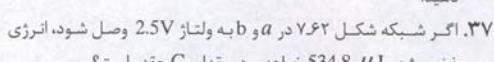
شکل ۷.۶۴

۵۵. از بسط مفهوم تبدیل Y-شبکه شکل ۷.۶۴ را ساده کنید. هر عنصر یک القایر InH است.

۵۶. با جمعهای بر از القایرها 1H به گویید با حداقل اجرا جگونه می‌توان القایر معادل (الف) $2.25\mu\text{H}$ و (ب) 750nH و (ج) 450nH داشت.

۵۷. با توجه به شکل ۷.۶۵ (الف) اگر هر عنصر یک مقاومت 10Ω باشد، R_{eq} را بدست آورید. (ب) اگر هر عنصر یک القایر 10H باشد، L_{eq} را تعیین کنید و (ج) اگر هر عنصر یک خازن 10F باشد، C_{eq} قدرت است؟

۵۸. با نظره از پایانه‌های a و b در شکل ۷.۶۱، شبکه را به یک القایر کاهش دهید.



شکل ۷.۶۱

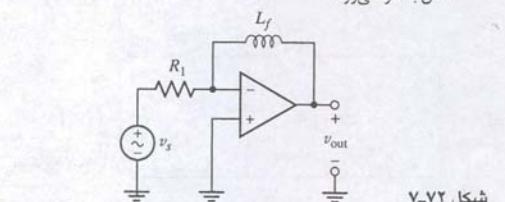
۵۹. اگر شبکه شکل ۷.۶۲ در a و b به ولتاژ 2.5V وصل شود، انرژی ذخیره شده ΔU خواهد بود، مقدار X چقدر است؟

خروجی اش مستقیماً متناسب با کل یون‌های برخوردی با سیلیکان باشد
(به آن dose می‌گویند).

۵۳. در مدار شکل ۷.۳۰ $R_i = \infty$, $C = 2\mu F$, $R = 0.5M\Omega$, $v_{out} = \cos 10t - 1 V$ و $R_0 = 0$ می‌باشد. فرض کنید که می‌خواهیم خروجی اش v_{out} باشد. (الف) $v_{out} = \cos 10t - 1 V$ (الف) اگر $A = 2000$ و (ب) A بی‌نهایت باشد.

۵۴. یک سنسور سرعت به یک جرخ دوار وصل است. مداری طراحی کنید که ولتاژ مشتبه تولید کند که اندازه‌اش با شتاب جرخ متناسب باشد (دور بر دقیقه بر دقتیه). فرض کنید خروجی سنسور سرعت $\frac{1 mV}{rpm}$ و جرخ در کمتر از $3500 rpm$ دور می‌زند.

۵۵. (الف) در مدار شکل ۷.۲۲ مقاومت و القایر را عوض می‌کنیم. عبارتی برای v_{out} با v_{in} به دست آورید. (ب) بگویید چرا چنین مداری در عمل به کار نمی‌رود.



۵۶. (الف) دوگان دقیق مدار شکل ۷.۶۹ را بکشید. متغیرهای دوگان و مقادیر اولیه دوگان را مشخص نمایید. (ب) معادلات گرهی را برای مدار دوگان بنویسید. (ج) معادلات مش را برای مدار دوگان بنویسید.

۵۷. دوگان دقیق مدار شکل ۷.۵۱ را رسم کنید. مدار را به فرم مرتب و تمیز با گونیا برای مدار دوگان رسم نمایید.

۵۸. دوگان دقیق در مدار شکل ۷.۷۳ را ترسیم نمایید. سعی کنید منظم باشد.

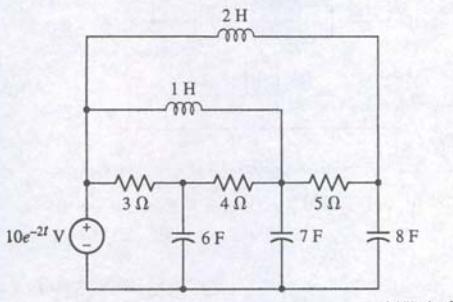
۶. مهندسین تست یک هوایپمای آزمایشی می‌خواهد. شتاب منفی را در هنگام فرود آمدن اندازه بگیرند، زیرا آن‌ها در مورد سیستم تعليق چرخ‌ها در ضمن فرود و میزان فشار بر آن تحقیق می‌کنند. اگر آن‌ها برای شما سیگنال ولتاژ از چرخ‌دنده‌ها را تهیه کنند به طوری که ۱ mV = ۱ mph متناسب با شتاب منفی ($V = 1 km/s^2$) باشد.

۷-۶ دوگانی

۶. (الف) دوگان دقیق مدار شکل ۷.۶۹ را بکشید. متغیرهای دوگان و مقادیر اولیه دوگان را مشخص نمایید. (ب) معادلات گرهی را برای مدار دوگان بنویسید. (ج) معادلات مش را برای مدار دوگان بنویسید.

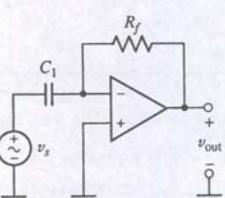
۷. دوگان دقیق مدار شکل ۷.۵۱ را رسم کنید. مدار را به فرم مرتب و تمیز با گونیا برای مدار دوگان رسم نمایید.

۸. دوگان دقیق در مدار شکل ۷.۷۳ را ترسیم نمایید. سعی کنید منظم باشد.



۶. (الف) دوگان دقیق مدار تمرین ۴۷ را رسم نمایید و در آن متغیرهای را نشان دهید. (ب) دوگان مسئله را برای تمرین ۴۷ بنویسید. (ج) تمرین ۴۷ جدید را حل کنید.

۷. دوگان مدار ۷.۷۴ را ترسیم کنید و عبارتی برای v_{out} بفراسب و v_{in} به دست آورید (راهنمایی: برای op amp از مدل مشروح استفاده کنید).



۷-۷ مدل‌سازی خازن‌ها و القایرها با PSpice

۶. انرژی ذخیره شده در القایر شکل ۷.۷۵ را محاسبه کنید. نتیجه خود را با PSpice چک کنید. نام مناسبی برای نتیجه انتخاب نمایید.

۷. مدل‌سازی خازن‌ها و القایرها با

۸. مدل‌سازی خازن‌ها و القایرها با

۵۸. یک سنسور شناور در یک تانک سوخت برای اندازه‌گیری سوخت باقیمانده نصب شده است. سنسور طوری کالیبره شده است که $1 volt = 10 liters$ خروجی اش مصرف سوخت را به لیتر بر ثانیه فراهم کند به نحوی که $1 V = 1 l/s$.

۵۹. قرار است یک باتری برای انرژی که می‌تواند به یک بار مقاومتی 1Ω حمل کند، مورد تست قرار گیرد. دو سیگنال در اختیار است: یکی سیگنال ولتاژ برای نشان دادن مربع جریان خروجی باتری $1 mV = 1 A^2$ (۱). مداری طراحی کنید که در آن ولتاژ خروجی $1 mV = 1 A^2$ متناسب با کل انرژی حمله شده باشد به طوری که $J = 1 A$. آنرژی تحويل شده به بار باشد.